DERWENT-ACC-NO:

1987-084066

DERWENT-WEEK:

198712

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Metallisation of ceramic for PCB of

IC - by baking mixt.

of copper cpd., silica, alumina with

zinc or zinc cpd. at

relatively low temp. and reducing

PATENT-ASSIGNEE: AGENCY OF IND SCI & TECHNOLOGY [AGEN]

PRIORITY-DATA: 1985JP-0176588 (August 9, 1985)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE PAGES MAIN-IPC

JP 62036091 A February 17, 1987 N/A

004 N/A

JP 90032235 B July 19, 1990 N/A

000 N/A

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

JP 62036091A N/A

1985JP-0176588 August 9, 1985

JP 90032235B N/A

1985JP-0176588 August 9, 1985

INT-CL (IPC): C04B041/88

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 62036091A

BASIC-ABSTRACT:

A mixt. consisting of at least one of CuCO3, CuSO4, CuS, CuO and CuCl2, at

least one of  $\mathrm{SiO2}$  and  $\mathrm{kaolin}$ , and at least one of  $\mathrm{Zn}$  and  $\mathrm{Zn}$  cpds. is coated on

the surface of the ceramic, baking at 900-1300 deg.C in oxidising atmos., then reducing the baked layer.

Pref. for forming a metallised layer on the surface of ceramics (silicon nitride. sialon, silicon carbide, aluminium nitride, alumina, zirconia, mullite, beryllia, magnesia, cordierite, etc.) are baked at lower temp. than conventional process, then reduced.

USE/ADVANTAGE - Obtd. metallised layer has electroconductivity, bonding strength, abrasion resistance, and chemical resistance; and is useful for ceramic package, PCB for 12 substrate, etc.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS: METALLISE CERAMIC PCB IC BAKE MIXTURE COPPER COMPOUND SILICA

ALUMINA ZINC ZINC COMPOUND RELATIVELY LOW TEMPERATURE REDUCE

ADDL-INDEXING-TERMS:

PRINT CIRCUIT BOARD INTEGRATE SIALON KAOLIN SILICON NITRIDE CARBIDE

ALUMINIUM MULLITE BERYLLIA MAGNESIA CORDIERITE

DERWENT-CLASS: L02 M13

CPI-CODES: L02-J01A; M13-B;

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 1526U; 1547U ; 1549U ; 1682U : 1759U

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1987-035189

# ⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-36091

(3) Int Cl. 1

識別記号

广内整理番号

⑩公開 昭和62年(1987)2月17日

C 04 B 41/88

7412-4G

審査請求 有 発明の数 1 (全4頁)

60発明の名称

セラミツクスのメタライズ法

②特 願 昭60-176588

22出 願 昭60(1985)8月9日

砂発 明 者 江 畑 儀 弘

川西市小花1丁目19番22号

⑫発 明 者 香山 正憲 信 幸 池田市五月丘3丁目4番8号 池田市五月丘3丁目4番8号

砂発 明 者 玉 利

砂発 明 者 木 実

池田市緑丘1丁目2番17号

工業技術院長 ⑪出 願 人

**①指定代理人** 

工業技術院 大阪工業技術試験所長

発明の名称 セラミツクスのメタライズ法 特許額求の範囲

① (i) 炭酸銅、硫酸銅、硫化銅、酸化銅及び 塩化銅の少なくとも1種、(ii)SiOa及び カオリンの少なくとも1種、並びに(#)更鉛 及びその化合物の少なくとも1種からなる混合 物をセラミックス表面に被擢し、酸化性雰囲気 中900~1300℃で焼付けた後、焼付け脂 を還元処理することを特徴とするセラミツクス のメタライズ法。

発明の詳和な説明

#### 産業上の利用分野

本発明は、セラミツクスのメタライズ法に関す る。

## 従来技術とその問題点

セラミツクスは、一般に耐熱性、耐熔耗性、絶 緑性等に優れているものの、耐衝球性に劣る為、

構造材料としては、金成との接合体として使用さ れることが多い。セラミツクスと金属とを接合す る場合には、予めセラミツクス表面をメタライズ しておく必要があり、又セラミツクスを導電材料 として使用する場合にも、その表面をメタライズ しておく必要がある。

セラミツクスのメタライズ法としては、テレフ ンケン法、活性金属法、水素化合物法、酸化物ソ ルダー法、炭酸級法等が知られているが、テレフ ンケン法以外の方法は、ほとんど使用されていな い。これは、工程が複雑であるのみならず、得ら れたメタライス層の接着強度、耐熱衝撃性、耐化 学薬品性等が充分でない場合が多いからである。 現在一般的に使用されているテレフンケン法にお いては、セラミツクス表面にモリブテン-マンガ ンを被覆し、非酸化性雰囲気中1400~

1700℃程度の高温で焼き付け処理した後、金 調メツキを行ない、次いで再度非酸化性雰囲気中 で加熱することにより、安定化したメタライズ膜を形成させている。しかしながら、この方法においても、多段階にわたる煩雑な工程が必要であり、加熱温度が高いという欠点が存在する。

なる混合物をセラミックス表面に被覆し、酸化性 雰囲気中900~1300℃で焼付けた後、焼付け層を還元処理することを特徴とするセラミックスのメタライズ法に係る。

本発明において被覆材として使用する炭酸期、 硫酸銅、硝化銅、酸化銅及び塩化銅は、いずれも 通常粉末の形態で用いる。粉末の粒度は、特に限 定されないが、通常100μm以下程度より好ま しくは50μm以下である。

SiO2及びカオリンも、粉末として使用することが好ましく、その粒度は、上記期化合物の場合と同様である。

本発明においては、被覆材として亜鉛及びその化合物の少なくとも1種を併用することが必要であり、このことによりメタライズ層の接着強度及び耐磨耗性が若しく向上する。亜鉛化合物としては、例えば酸化亜鉛、炭酸亜鉛、リン酸亜鉛、塩化亜鉛、シアン化亜鉛、硫化亜鉛、水酸化亜鉛、

出願済である (特別的 5 9 - 2 0 7 8 8 7 号、特開的 6 0 - 2 1 8 8 8 8 3、特願的 5 9 - 2 0 7 6 8 5 号、特願的 5 9 - 2 0 7 6 0 - 5 2 8 4 3 号等)。

#### 間短点を解決するための手段

本発明者は、セラミックスのメタライズ法につき更に研究を進めた結果、炭酸期等の網化合物、SiO2及びカオリンの少なくとも1種並びに垂動及びその化合物の少なくとも1種からなる混合には、やはり低温下での簡易な操作により、各種の物性に優れ、更に接着強度及び耐軽耗性が著しく向上したメタライズ層が得られることを見出し、本発明を完成した。

即ち、本発明は、(i)炭酸銅、硫酸銅、硫化 綱、酸化銅及び塩化桐の少なくとも1種、(ii) SIO2及びカオリンの少なくとも1種、並びに (iii) 亜鉛及びその化合物の少なくとも1種から

鍵化亜鉛等を挙げることができる。亜鉛及びその 化合物も、粉末として使用することが好ましく、 その粒度は、前記銅化合物の場合と同様である。

ましくない。

本発明方法は、通常以下の様にして実施される。 上記の組成を有する被覆材を粉末状態で又はペー スト化して、メタライズ暦を形成すべきセラミツ クス表面に撒布又は塗布して被覆する。ペースト 化する場合には、粉末混合物に適宜パインダー及 びその溶剤、例えばパルサム、スクリーンオイル 等を遊り加えればよい。セラミツクスに対する被 覆畳は、特に限定されず、所望のメタライズ層の 厚さに応じて適宜決定される。次いで、被覆され たセラミツクスを酸化性雰囲気中で加熱し、被覆 腐を焼付ける。酸化性雰囲気としては、特に限定 されないが、特殊なものを使用する必要はなく、 空気、空気と変素との混合気等を使用すればよい。 加熱条件は、セラミツクスの形状及び寸法、被額 材の組成及び被覆債等により変り得るが、適常 900~1300で程度で5~60分間程度加熱 する。かくして、酸化銅以外の銅化合物は酸化銅

網及び酸化亜鉛が銅及び亜鉛に進元されるならば、 特に限定されない。代表的な還元処理方法として は、水素雰囲気、一酸化炭素雰囲気等の遅元性雰 囲気中での加熱、エタノール、メタノール、プロ パノール等のアルコール類、石油ペンジン、ホル ムアルデヒド等の選元性溶媒への捜査、ジメチル アミンポラン水溶液への浸渍等を挙げることがで きる。遠元性雰囲気中で加熱する場合の温度は、 焼付け層の分解、変質等を防ぐために前記焼付け 温度よりも低いことが好ましく、通常200~ 900℃程度とし、時間は適常5~60分間程度 とする。また、選元性溶媒への浸漬による場合は、 セラミックスを通常200~500℃程度好まし くは300℃前後に加熱後上記還元性溶媒に10 ~60秒間程度浸漉すれば良い。また、ジメチル アミンポラン水溶液への受資による場合は、セラ ミツクスを通常40~60℃程度に加熱後、該水 溶液に10~60秒間程度浸渍すれば良い。

となり、亜鉛及び/又は酸化亜鉛以外の亜鉛化合 物は酸化亜鉛となつて、酸化與及び酸化亜鉛を主 体とし且つSi02及び/又はカオリン粉末を含 有する被膜がセラミツクスに密着する。この際、 酸化桐の融液の一部がセラミツクス内に浸透する ので、得られるメタライズ関の培養強度が向上す る。又、亜鉛及び/又はその化合物の併用により、 メタライズ脳の接着強度が著しく改善されるのみ ならず、耐磨耗性も大きく改善される。更に、 SiO₂及び/又はカオリンの使用により、メタ ライズ篇の均一性、表面の平滑性及び光沢が若し く高められる。加熱温度が900℃未満の場合に は、セラミックス内への酸化銅融液の浸透が充分 でない為、接着強度が不充分となり、一方 1300℃を上回る場合には、被覆層の粘性が低 下して、筬出する危険性がある。

次いで、上記の如くして焼付け層を形成されたセラミツクスを選元処理する。還元方法は、健化

上記還元処理により極めて優れた夢電性を有する鋼ー亜鉛を主体とするメタライズ層がセラミツクス表面に形成される。このメタライズ層表面には、過常、亜鉛の結晶が認められる。

斯くしてメタライズされたセラミックスには、 必要に応じて、常法例えばロウ接等により、各種 金属を容易に接合することができる。

本発明によりメタライズできるセラミツクスとしては、特に限定されず、例えば変化球素、サイアロン、炭化珪素、変化アルミニウム等の非酸化物系セラミツクス、アルミナ、ジルコニア、ムライト、ペリリア、マグネシア、コージライト等の酸化物系セラミツクスを挙げることができる。

### 発明の効果

本発明によれば、従来法に比べて低温で焼付け 後、選元処理するという極めて簡便な操作で、セ ラミツクス表面にメタライズ瘤が形成できる。 得 られたメタライズ幣は、導電性に優れ且つ接着強

# 特開昭62-36091 (4)

度、耐磨耗性及び耐化学薬品性が極めて高く、またメタライズ腫の均一性、特に表面の平相性及び 光沢に優れているので、商品価値が高い。

本発明によりメタライズされたセラミツクスは、 上記の如き性能を有するので、セラミツクスパツ ケージ、IC越板のプリント配線等の電子部品、 セラミツクスを用いた耐磨耗性部局、耐熱性部局 等に好適に使用できる。

# 寒 施 例

以下、実施例を挙げて、本発明を更に具体的に説明する。

#### 突旋例 1

4 ....

酸化解粉末(粒度 5 μm) 6 0 重量部に対してカオリン粉末(粒度 5 μm) 1 0 重量部、酸化亚鉛粉末(粒度 5 μm) 3 0 重量部及びパルサム1 0 重価部を設合してペースト状とし、これを平板正方形の変化珪素、サイアロン、炭化珪素、アルミナ及びジルコニアの夫々の焼結体の表面に

第1表に示す如く、いずれも極めて強く接着され ていることが判明した。

第 1 表

セラミツク	電気抵抗	<b>d</b> (Ω)	接着強度
ス焼桔体	選元前	還元後	(kg / cal)
窒化珪素	1,3×10 <sup>7</sup>	0	550
サイアロン	1.3×10 <sup>7</sup>	0	5 4 5
炭化珪素	1.2×10 <sup>7</sup>	0	470
アルミナ	1.2×10 <sup>7</sup>	0	870
ジルコニア	1.3×10 <sup>7</sup>	0	850

#### 実施例2

酸化亜鉛粉末に代えて亜鉛粉末(粒度 5 μm)を用いた他は、実施例 1 と同様にしてメタライズ 瘤を形成した。

メタライズ閥の耐磨耗性を実施例 1 と同様にし て調べたところ、著しく向上していることが判つ ○・10/cm² 塗布した。次いで、電気炉を用いて空気中にて各焼精体を1100℃で20分間焼成した。引続き焼成した。引続き焼成した。引続き焼成したものを乾燥器中で50℃に加熱した後、ジメボランの5%水溶液中に浸透した。これである。で焼付け被覆層が遅元され、金属銅ー亜鉛を主体とするメタライズ層が形成された。下配第1 表に遠元前後における電気低抗値(電圧1000 V)を示す。違元後のメタライズ層は、極めて優れた導電性を有していることが明らかである。

上記で形成されたメタライズ層の耐磨耗性を調べるため、メタライズ圏の表面をサンドベーパーで摩徴したところ、殆んど傷が付かず、耐磨耗性が若しく向上していることが判つた。

かくして得たメタライズ層を有する各セラミックスと網片とを銀口ウを用いて口ウ接し、秤量2ton、及び荷重速度5mm/min の引張試験機を用いて、メタライズ層の接着強度を測定したところ、

た。また、メタライズ層の準電性及び接着強度も、 下記第2次に示す通り、極めて優れていることが 判つた。

数 2 表

セラミツク	電気抵抗	<b>ā</b> (Ω)	接着強度
ス焼結体	退元前	建元後	( kg / cm²)
空化珪素	1.8×10*	0	5 2 0
サイアロン	1.7×10 <sup>8</sup>	0	5 3 0
<b>炭化珪素</b>	1.7× 10 <sup>8</sup>	0	450
アルミナ	1.3×10°	0	8 4 0
ジルコニア	1.4×10 <sup>8</sup>	0	810

(以上)